
	<h2 style="color: red;">SI7111EDN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7111EDN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 60A POWERPAK1212</p> <p>Datenblätter:  SI7111EDN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7111EDN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 60A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.55 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7111EDN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5860pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 2.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 60A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SI7111EDN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7111EDN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7111EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7111EDN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7112DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p>	 <p>SI7112DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p>	 <p>SI7112DN-T1 VISHAY SI7112DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7110DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>
 <p>SI7110DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>	 <p>SI7110DN VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7111EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7111EDN-T1-GE3 Datenblatt	SI7111EDN-T1-GE3-Datenblätter	SI7111EDN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7111EDN-T1-GE3
SI7111EDN-T1-GE3 Electronic	SI7111EDN-T1-GE3-Komponenten	SI7111EDN-T1-GE3-Verteiler	SI7111EDN-T1-GE3-Bild	SI7111EDN-T1-GE3-Teil
SI7111EDN-T1-GE3 Preis	SI7111EDN-T1-GE3 Hersteller	SI7111EDN-T1-GE3 Bild	SI7111EDN-T1-GE3 Aktie	SI7111EDN-T1-GE3 Inventar
SI7111EDN-T1-GE3 Neu	SI7111EDN-T1-GE3 Original	SI7111EDN-T1-GE3 garantiert	SI7111EDN-T1-GE3 RFQ	SI7111EDN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited